

双芯片 P 沟道器件 刷新业内最低导通电阻纪录

成都方舟微电子最近又推出新款器件：双芯片 20V P 沟道功率 MOSFET—AKF20P45D。新器件采用紧凑的 DFN2X2 封装，不仅有优秀的散热能力，还具有业界最低的导通电阻：在 4.5V 栅源电压下提供 35m Ω 超低导通电阻。同时该器件还有非常高的可靠性，能达到至少 2500V 的 ESD 保护能力。

AKF20P45D 在 4.5V、2.5V、1.8V 和 1.5V 时分别具有 35m Ω 、50m Ω 、100m Ω 和 160m Ω 的超低导通电阻。性能达到并超过 Vishay 公司的 SiA923EDJ，可以在光模块、智能仪器仪表等领域替代进口器件。也可用于智能手机、充电器、锂电池保护等。更低的导通电阻意味着更低的传导损耗，从而节省电能提高能效，并延长两次充电之间的电池寿命。

新款双芯片 P 沟道功率 MOSFET：AKF20P45D 现可提供样品，目前已实现量产，交货周期为十四周到十六周。